

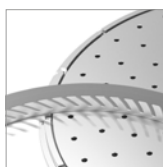
ADVANCED PACKAGING 先进封装



引领先进封装全新境界



随着对电子产品的功能性和可靠性不断的进步, 对于系统的集成和发展提出了不断优化的要求。由此, 相关材料、化学品及其辅材的性能、可靠性和经济性就成了市场所关注的焦点。



鉴于此, 优美科联合昕皓材料正式向市场推出创新型的半导体先进封装镀铜添加剂、氧化铜、阳极和阴极, 用以服务不同的电镀制程和设备。

www.mds.umicore.com
www.shinhaomaterials.com




umicore
Metal Deposition Solutions

IntraCu[®] Electrolytes

IntraCu[®] SC-2系列产品

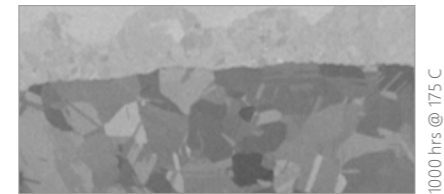
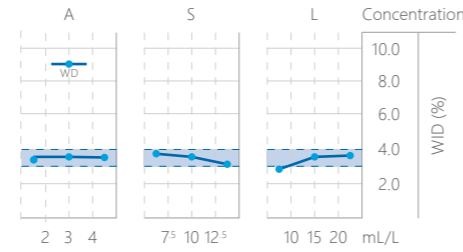
该系列产品可以通过大幅度拓展工艺窗口从而提供给客户一个降低生产成本的机会。而且，这是一款真正的二合一产品，(既可以电镀RDL, 又可以电镀Pillar)，它可以做到极少量的柯肯达尔孔洞 (Kirkendall voids)，这个体系是一个针对当前POR产品的降低成本的可替代产品。

产品特征

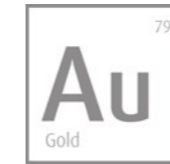
- 亮铜，粗糙度小于0.03 μm
- 对于铜柱和再布线层，都有±50%工艺窗口
- 铜层中总的有机物含量小于11ppm
- 极少的柯肯达尔孔洞，KV表现优异

产品应用

- 二合一 (铜柱和再布线层) 电镀亮铜
- 二合一, 对没有或极少的柯肯达尔孔洞的要求



Umicore Electrolytes

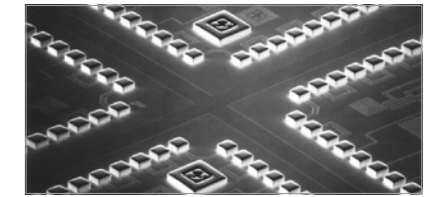


Umicore AURUNA[®] SC

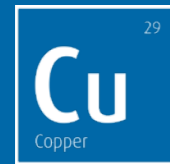
不含氰化物的电镀金工艺，镀层金含量可达99.99%。该工艺适用于小间距的晶圆RDL和凸点电镀。

由于是PH中性的体系，AURUNA[®]能与该应用下的大部分常见光刻胶兼容。

该工艺也提供了非常宽的电流密度范围，并且电镀效率稳定(最高可达1.2A/dm²)。

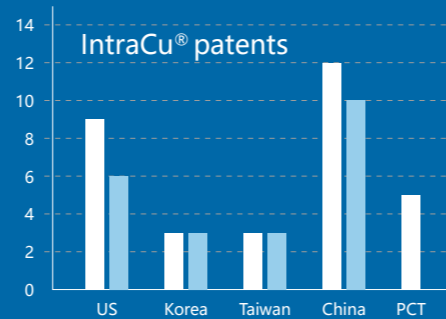


Bump plating on test structure



我们的添加剂组合旨在满足半导体行业先进封装领域的最严苛要求，并为沉积定制材料特性打下了基础，例如IC封装中的微凸块、晶圆级封装中的 RDL 和倒装芯片封装中的支柱。

Patent Applications ■ Issued Patents ■

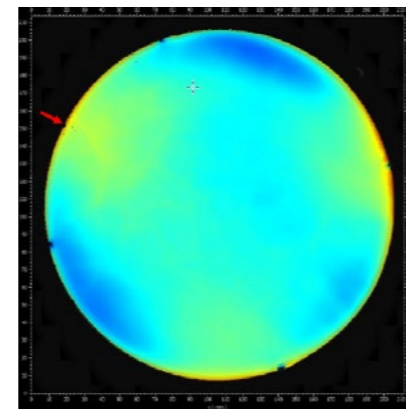
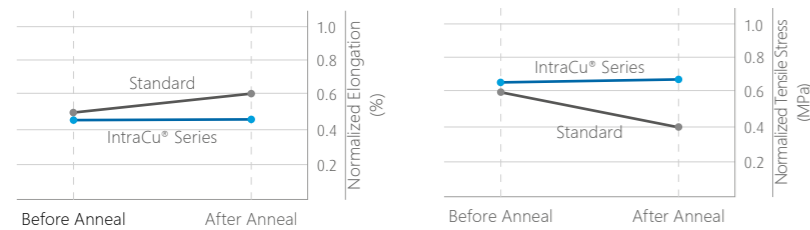


umicore
Metal Deposition Solutions

IntraCu[®] SC-6

该体系提供给客户用于未来对产品的热力学稳定性要求的场景，以致对于精细线路和微观结构在后续的封装或者组装操作中不会断裂。特别对于TAIKO晶圆来说，这个工艺确保玻璃或陶瓷基板没有翘曲和损伤

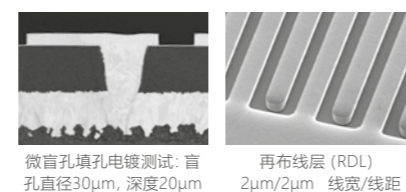
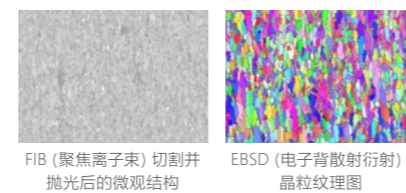
IntraCu[®] SC 6制备的铜层提供了最佳结合力，主要归因于低的铜层内应力



无应力/低应力 IntraCu[®] 铜层: 8英寸空白晶圆

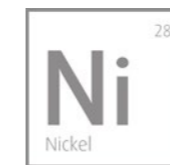
IntraCu[®] SC-4

该体系特别针对解决微观形貌的要求来开发的Cu-Cu对接产品，主要归因于其独特的晶粒微观结构。其微观形貌维持最大程度的不变，即使经过热过程(退火、烘烤、回流焊等)后，仍然提供最佳的焊盘高度一致性，从而在满足Wafer-Wafer对接确定性标准下，保证更好的键合



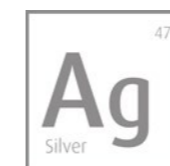
IntraCu[®] VF-9

该系列产品可以将盲孔填平和精细的再布线层电镀同步完成，而且电镀均匀性优秀，特别适用于面板级封装的应用。



Umicore NiRUNA[®] SC

氨基磺酸镍电镀工艺，应力极低，有不含硼酸的版本。



Umicore ARGUNA[®] SC

较弱的碱性无氰化物镀银工艺。 ARGUNA[®]镀层的纯度可达99 % 以上，同时镀层的电导率以及可焊性都可以媲美常规氰化物镀银。该体系与大部分的光刻胶都有良好的兼容性。



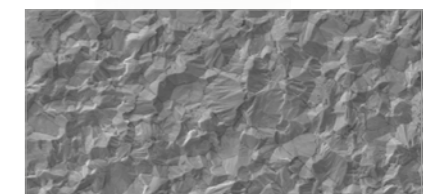
Umicore Tin SC

纯锡电镀工艺，有非常宽的电流密度范围。锡镀层的纯度非常高，并且不易产生锡须。是各组分非常稳定的甲基磺酸锡电镀工艺。

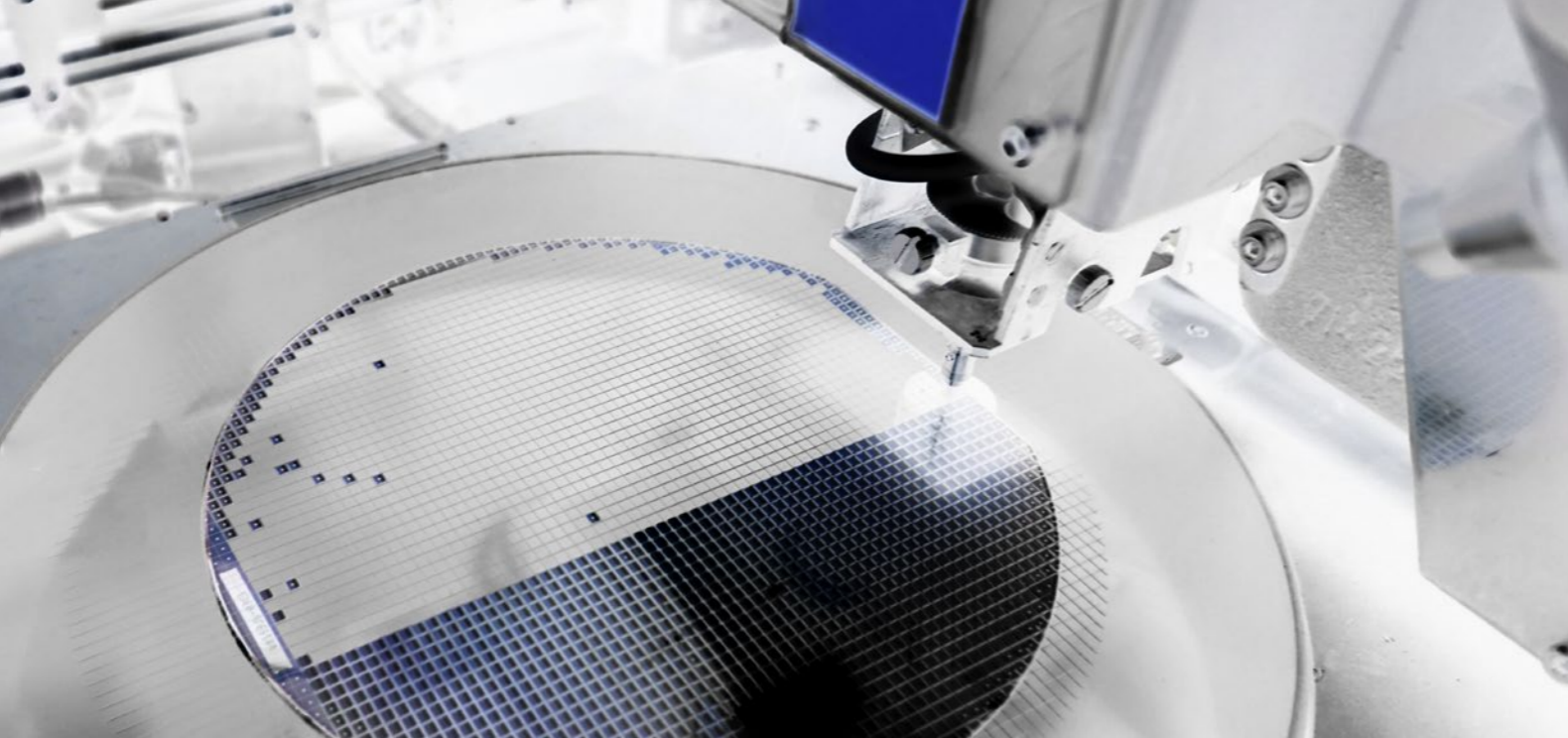


Umicore Indium SC

该工艺可以在非常宽的电流密度范围内沉积纯锡。该电镀体系非常稳定，所有组分都可分析，并且镀层有良好的覆盖能力以及均匀的晶粒尺寸。



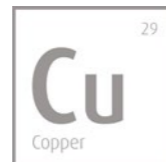
Typical grain structure Umicore Indium SC



先进封装

半导体行业完美电化学沉积产品

氧化铜 高纯金属盐



优美科高纯度金属氧化铜粉末按照半导体先进封装行业的苛刻要求进行开发、制造和质量测试。结合Ancosys DMR 概念(直接补给金属) 洁净室的应用,可以降低补加铜的成本,同时通过更高的铜浓度提高电解质的性能。

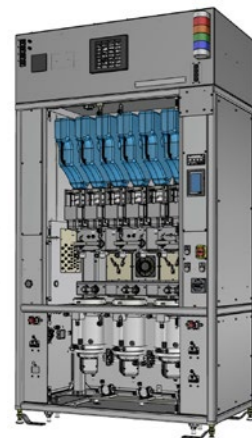
	优美科 CuO PG	优美科 CuO HG	优美科 CuO 4N
应用	RDL和面板级基板	板材基板	精细线路RDL和支柱
纯度	99,9 %	99,9%	99,99%
自动补加DMR	✓	-	✓
溶解速度	★	★	★★
高速电镀	✓	✓	✓
洁净室包装/兼容	✓	-	✓

不需要VMS

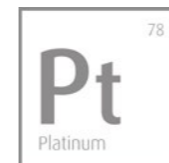
- 保持恒定的硫酸浓度 镀液体积稳定, 无需补加和更新。
- 多个产品级别 (4N, 封装)
- 全程可追溯, 单一铜货源

成本效益

- 减少停机时间, 支持免维护电镀槽
- 与 VMS 相比, 每公斤Cu 的成本降低了 50%
- 通过更高的 Cu²⁺ 含量可加快 15% 的电镀速度(60g/l i/o 50g/l)



Picture: Courtesy ancossys GmbH

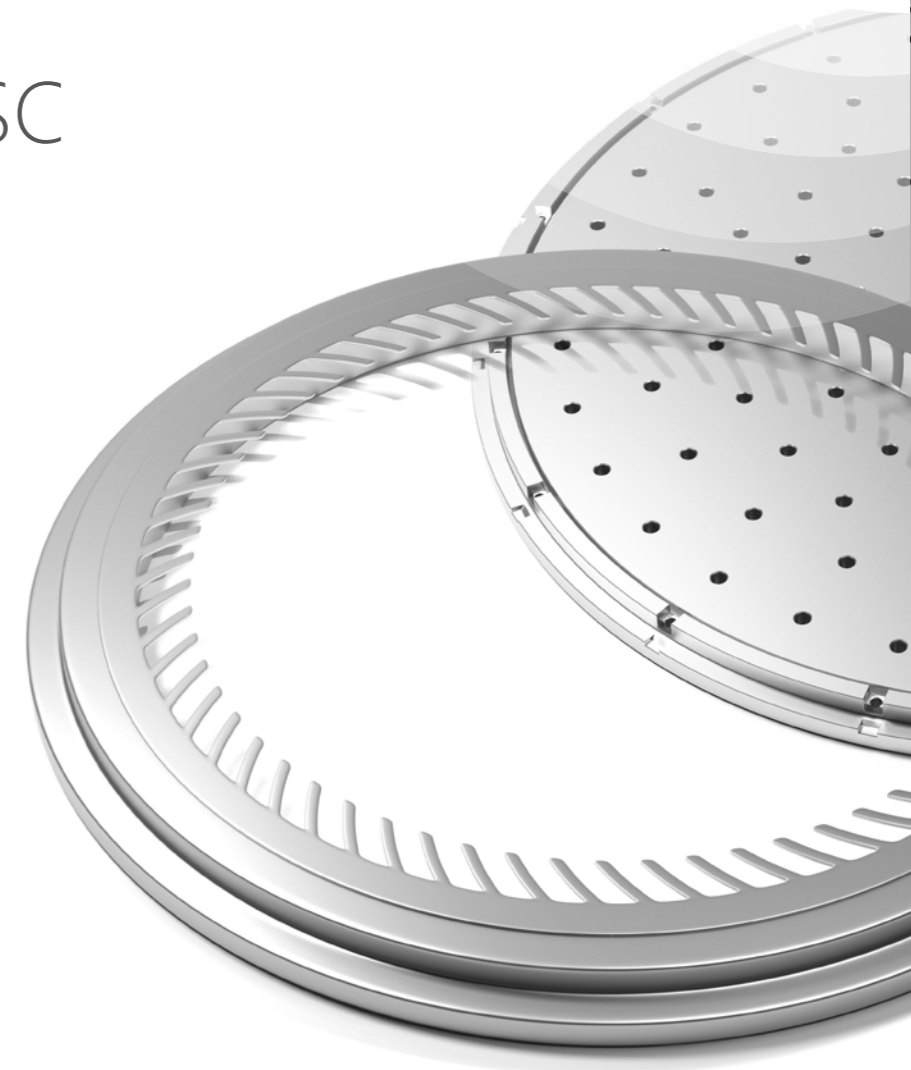


PLATINODE® SC 电极

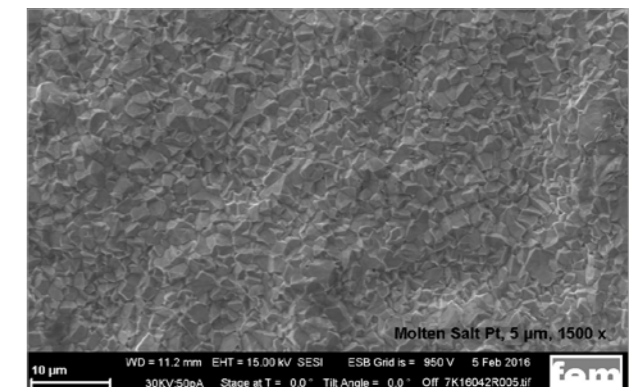
在先进封装电镀制程中, 不溶性阳极有助于提高工艺效率, 降低工艺成本, 环境影响和工艺控制工作量。优美科的 Platinode® 的关键差异性在于异质层整合技术, 这是由于熔融盐电解质的制造工艺即使在Pt 层很厚的情况下也可以获得超高纯度、低孔隙度和最佳延展性。

- 功能: 基于独特的 HTE™ 电极涂层, 可提供一流的延展性和耐化学性
- 定制的设计、触点材料和涂层
- 完全集成的生产和洁净室包装: 按订单或批量生产
- 多个WLP/PLP ECD设备验证的不溶性阳极和阴极

PLATINODE® SC PtTi	PLATINODE® SC MMO
Pt熔融盐沉积在Ti衬底上	低添加剂消耗量
高电流密度, 可期望的寿命, 和杰出的电流分布准确性	通过电催化和消耗速率表征寿命
厚度可以测量/与寿命可关联	厚度无法测量/与寿命无法关联



SEM
Surface morphology 5000x



Molten Salt Pt, 5 µm, 1500 x
10 µm IWD = 11.2 mm EHT = 15.00 kV SEI ESB Grid is = 950 V 5 Feb 2016
30KV/50pA Stage at T = 0.0° Tilt Angle = 0.0° Off 7K16042R005.tif **fem**

Passion for perfect surfaces

More information



www.mds.umicore.com
www.shinhaomaterials.com



联系人

张芸博士
CEO & CTO
电话: +86 1589 5537 107
yunzhang@shinhaomaterials.com

苏州昕皓新材料科技有限公司
中国江苏省苏州市吴江经济技术开发区

成立于2012年，致力于半导体先进封装领域产品创新和工艺技术。

在先进封装电镀铜添加剂领域获得多项专利。

研发、制造和QA/QC位于中国苏州，通过了ISO 9001 和 ISO 14001 体系认证。

联系人

Volker Wohlfarth
Sales Manager & Technical Services
电话: +86 1832 1055 985
ep.semiconductormaterials@eu.umicore.com

UMICORE GALVANOTECHNIK GMBH

Klarenbergstrasse 53-79
73525 Schwaebisch Gmuend
Germany

UMICORE S.A.全球拥有11150多位员工，分布在50余个场所，2019年总收入为34亿欧元。

其中电镀事业部是贵金属电镀领域的领导者。

专注半导体领域，建立了全球生产，质控，销售和市场及物流能力。